

1ch ゲートドライバ

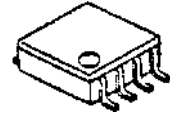
■ 概要

NJW4841 は、出力ピーク電流 2A の電流を供給できるゲートドライバです。

40V耐圧で幅広い動作電圧(4Vから20V)や、高速スイッチングが可能です。

サーマルシャットダウン機能を搭載しており、モータ駆動、スイッチング電源などに最適なゲートドライバです。

外形

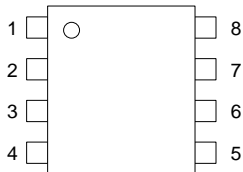


NJW4841R

■ 特長

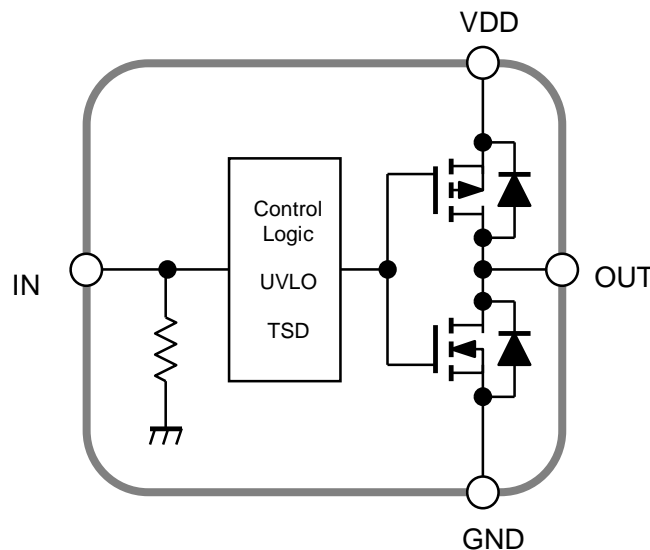
- 出力ピーク電流 ±2A (peak)
- 動作電圧範囲 4V to 20V
- 高速スイッチング tr/tf=25ns/20ns(typ.) at $C_L=2200\text{pF}$
- 3V / 5V 系ロジック対応
- サーマルシャットダウン
- 低電圧誤動作防止回路
- 高放熱パッケージ VSP8

■ 端子配列



- | | |
|--------|--------|
| 1. GND | 5. GND |
| 2. GND | 6. GND |
| 3. GND | 7. OUT |
| 4. IN | 8. VDD |

■ ブロック図



NJW4841-T1

■ 絶対最大定格

(Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位	備考
電源電圧	V _{DD}	+40	V	VDD-GND端子
入力電圧	V _{IN}	-0.3 to +6	V	IN-GND端子
消費電力	P _D	720 (*1) 1100 (*2)	mW	-
接合部温度範囲	T _J	-40 to +150	°C	-
動作温度範囲	T _{opr}	-40 to +125	°C	-
保存温度範囲	T _{stg}	-50 to +150	°C	-

(*1): 基板実装時 76.2 × 114.3 × 1.6mm(2層 FR-4)でEIA/JEDEC 準拠による

(*2): 基板実装時 76.2 × 114.3 × 1.6mm(4層 FR-4)でEIA/JEDEC 準拠による (4層基板内箔 : 74.2 × 74.2mm)

■ 推奨動作条件

(Ta=25°C)

項目	記号	最小	標準	最大	単位	備考
動作電源電圧	V _{DD}	4.0	-	20	V	VDD-GND 端子
入力電圧	V _{IN}	0	-	5.5	V	IN-GND 端子

■ 電気的特性

(特記事項なき場合、 $V_{DD}=16V$, $T_a=25^\circ C$)

項 目	記 号	条 件	最小	標準	最大	単位
-----	-----	-----	----	----	----	----

全体

電源電流	I_{Q1}	$V_{IN}=5V$	-	1.5	2.5	mA
		$V_{IN}=5V, T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	-	-	2.5	
	I_{Q2}	$V_{IN}=0V$	-	1.3	2.3	mA
		$V_{IN}=0V, T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	-	-	2.3	

出力部

出力ピーク電流	I_{PK1}	Pulse Width $\leq 10\mu s$, $V_{OUT}=0V$	-	2	-	A
	I_{PK2}	Pulse Width $\leq 10\mu s$, $V_{OUT}=16V$	-	2	-	A
出力オン抵抗	R_{DSH}	$I_{O-SOURCE}=100mA$	-	2.1	3.9	Ω
	R_{DSL}	$I_{O-SINK}=100mA$	-	1.5	2.8	Ω
出力プルダウン抵抗	R_{OUTPD}		60	100	140	$k\Omega$
		$T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	40	-	160	

入力回路部

IN端子 High電圧	V_{IHIN}		2.0	-	5.5	V
		$T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	2.0	-	5.5	
IN端子 Low電圧	V_{ILIN}		0	-	0.8	V
		$T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	0	-	0.8	
入力プルダウン抵抗	R_{INPD}		60	100	140	$k\Omega$
		$T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	40	-	160	

低電圧誤動作防止(UVLO) 回路

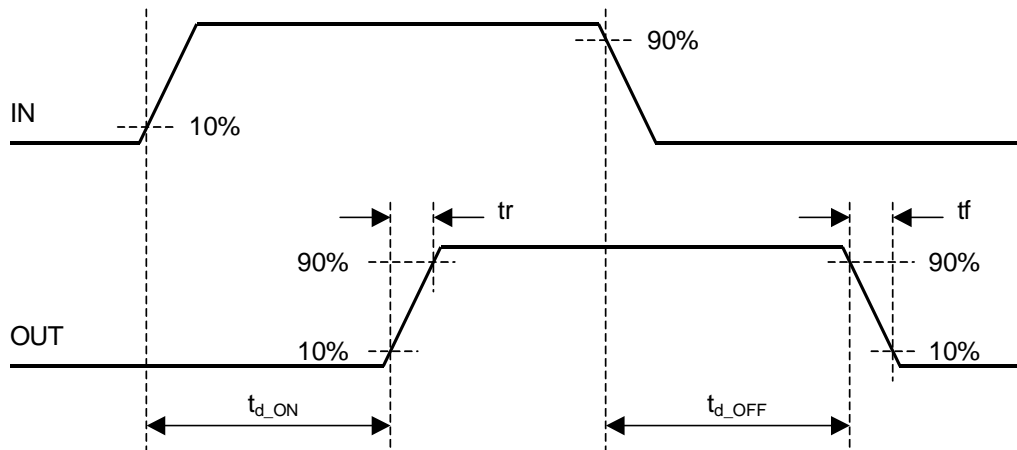
UVLO 解除電圧	V_{UVLO2}		2.8	3.3	3.8	V
		$T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	2.8	-	3.8	
UVLO 動作電圧	V_{UVLO1}		2.5	3.0	3.5	V
		$T_a=-40 \text{ to } +125^\circ C$	2.5	-	3.5	
UVLO ヒステリシス電圧幅	V_{UVLO}	$V_{UVLO2} - V_{UVLO1}$	-	0.3	-	V

出力立ち上がり/立ち下がり特性

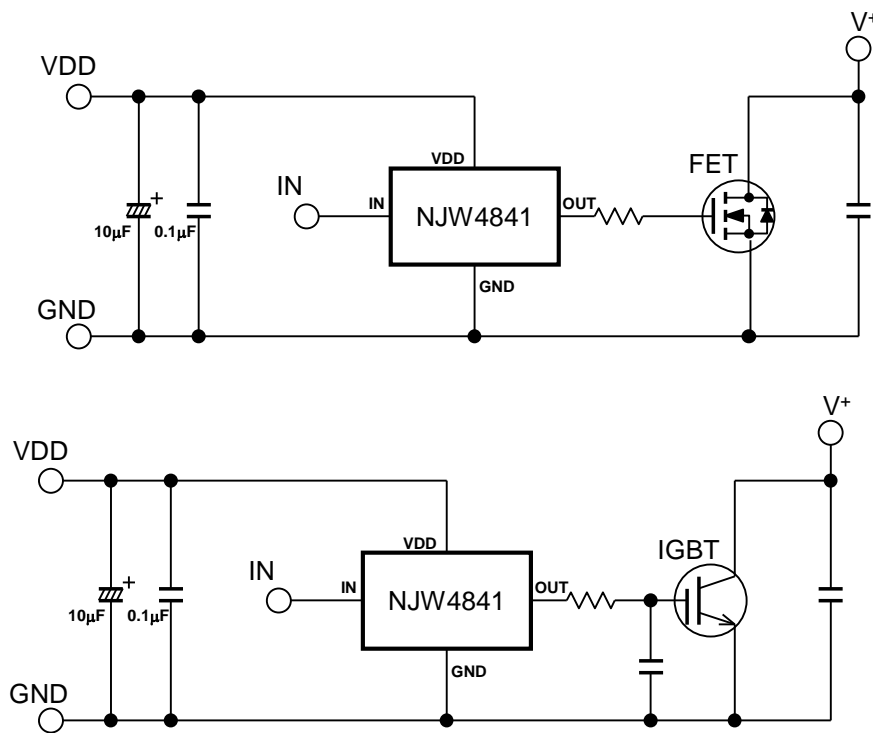
出力立ち上がり時間	t_r	$C_L=2200pF, V_{IN}=0 \text{ to } 5V$	-	25	-	ns
出力立ち下がり時間	t_f	$C_L=2200pF, V_{IN}=5 \text{ to } 0V$	-	20	-	ns
立ち上がり遅延時間	t_{d_ON}	$C_L=2200pF, V_{IN}=0 \text{ to } 5V$	-	40	-	ns
立ち下がり遅延時間	t_{d_OFF}	$C_L=2200pF, V_{IN}=5 \text{ to } 0V$	-	45	-	ns

NJW4841-T1

■ タイミングチャート



■ 応用回路例

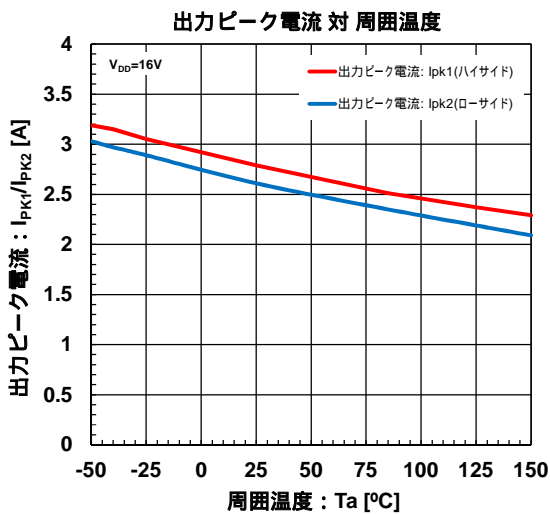
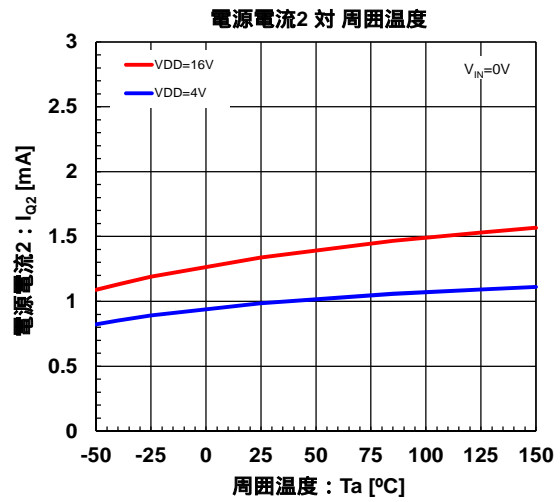
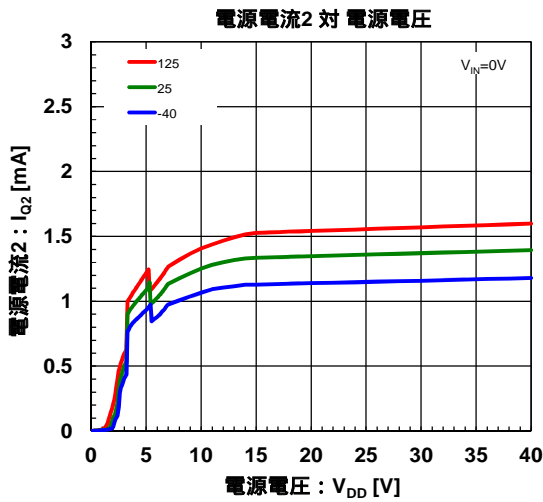
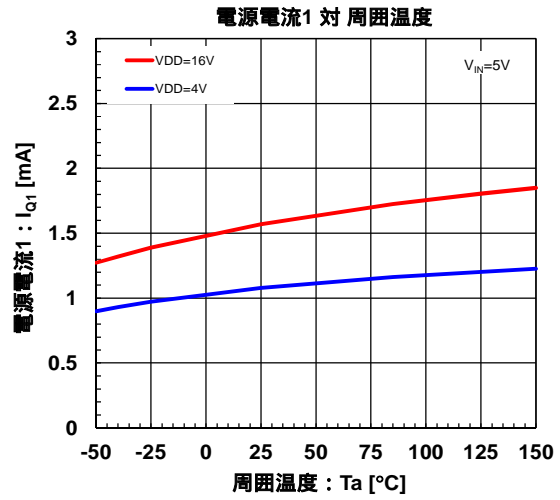
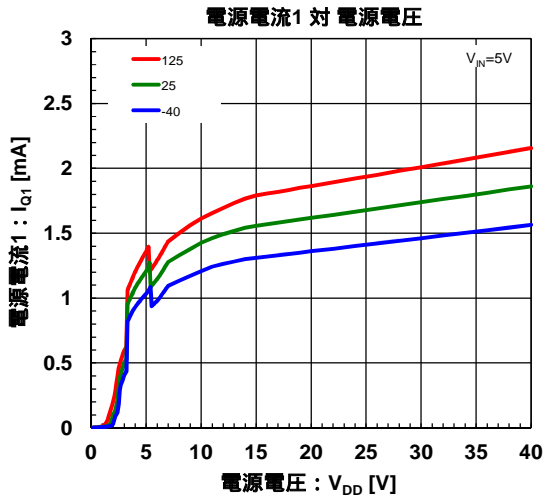


大電流、高速スイッチングを行う NJW4841 のアプリケーションは、出力の立ち上がり/立ち下がりに応じて電流が流れるため基板レイアウトが重要な項目です。

NJW4841 は、スイッチング時の損失を抑えるためにゲートを高速駆動しています。ハイサイド、ローサイド SW に流れる高速の電流変化が、配線の寄生インダクタンスによって過渡電圧を発生させるため、大電流の流れるラインは太く、短くし、電流ループ面積を最小限にすることで過渡電圧の低減を図ってください。あわせて、過渡電圧発生による誤動作・最大定格の超過を防ぐために、電源ライン(VDD 端子) - GND 間にはバイパスコンデンサを挿入してください。バイパスコンデンサには高周波特性の優れた 0.1µF 以上のセラミックコンデンサを推奨します。

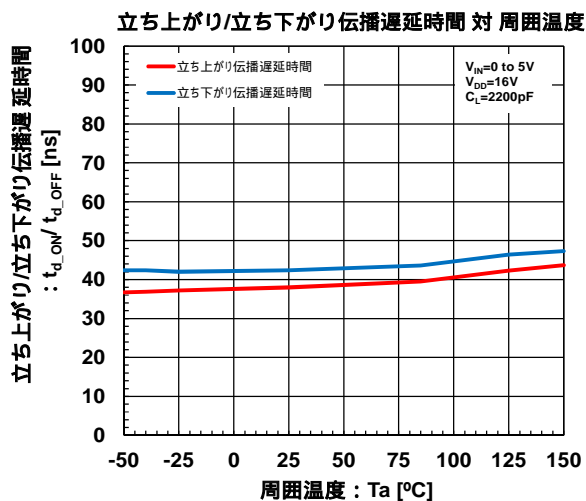
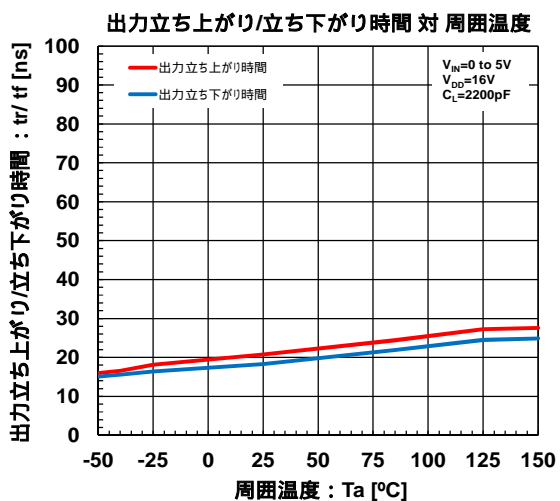
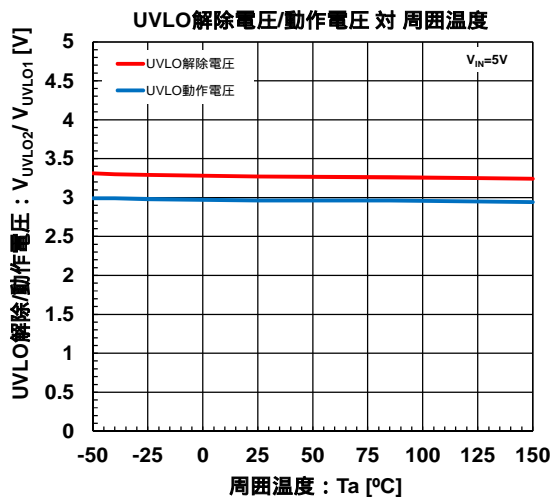
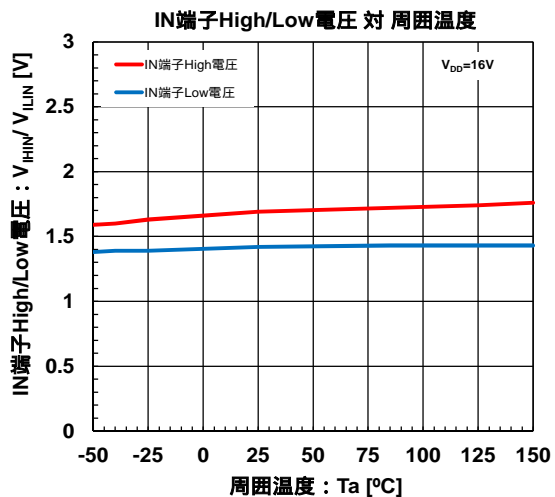
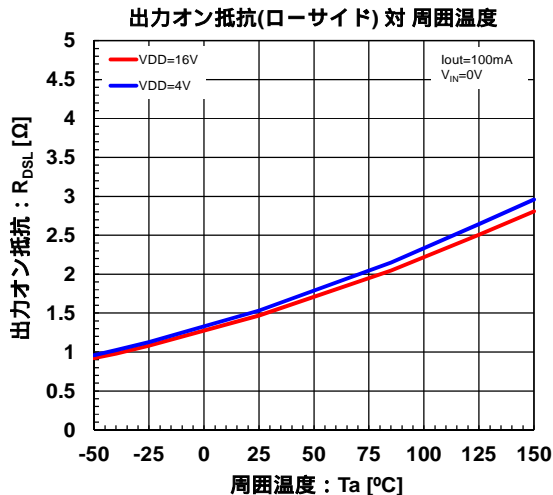
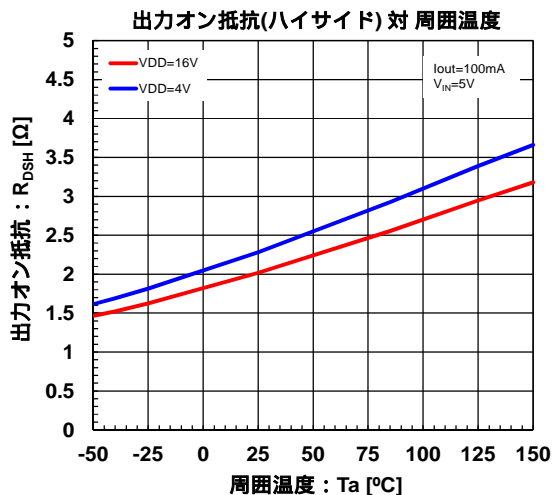
エネルギー吸収用のバイパスコンデンサとして、10µF の電解コンデンサを標準としています。負荷の特性やアプリケーション環境に応じてこれ以上の容量を確保してください。これらのバイパスコンデンサは、VDD 端子の近傍に接続する必要があります。

■ 特性例



NJW4841-T1

■ 特性例



<注意事項>

このデータシートの掲載内容の正確さには万全を期しておりますが、掲載内容について何らかの法的な保証を行うものではありません。とくに応用回路については、製品の代表的な応用例を説明するためのものです。また、工業所有権その他の権利の実施権の許諾を伴うものではなく、第三者の権利を侵害しないことを保証するものでもありません。